2D20

酸化チタン光触媒で生成する OH ラジカルの生成機構

(長岡技科大工) 村上 能規,太田 育樹,遠藤 健史,野坂 篤子,野坂 芳雄

【序】近年、酸化チタン光触媒作用が表面吸着種のみならず、酸化チタン表面と直接接触して いない固体を酸化できることが明らかになってきた。その酸化力の強さから、酸化チタン光触 媒表面から酸化力の強い活性酸素種であるOHラジカルが飛散し、固体を酸化するという機構 が考えられている。一方、酸化チタン光触媒の酸化反応活性種としてOHラジカルが生成する 機構(H2O+h+ H⁺+・OH)については、このような過程を否定する報告が複数あり、この機 構でOHラジカルが生成するとは考えにくい。一方、立間らはフローリアクターの実験におい て酸化チタン光触媒表面から気相中にH2O2が脱離することを確認し、非接触型光触媒作用は酸 化チタン光触媒反応によるH2O2生成過程とH2O2の光解離によるOHラジカル生成過程の二つ の過程が関与することで進行しているという説を提案している。そこで、本研究では酸化チタ ン表面から気相中に脱離したOHラジカルをレーザー誘起蛍光法により直接検出することで、 非接触型光触媒作用において重要であると考えられているOHラジカル生成の時間変化の測定 を行うとともに、その発生機構について検討することを目的とする。

【実験】反応容器に保持させたホルダーに酸化チタ ン粉末を充填した後、真空排気した。その後、波長 355 nm のレーザー光(約3 mJ / pulse)を酸化チタン 粉末表面に照射、355 nm レーザ-光照射からある 遅延時間をおいて YAG レーザー励起色素レーザー の3倍波光を酸化チタン粉末表面に対して平行に約 3~5mm 上部において照射することで酸化チタン粉 末表面から脱離した OH ラジカルをレーザー誘起蛍 光(LIF)法により検出した。レーザー誘起蛍光の検出 は色素レーザ3倍波光の酸化チタン粉末表面および ホルダーによる光散乱の影響を防ぐため、励起波長 (282~284 nm: OH(A-X,1'-0") band)とは異なる波 長(310 nm: OH(A-X,1'-1") band)の光をモノクロメ ーターにより分光し、光電子増倍管により検出する ことで行った。光電子増倍管で検出された信号はボ ックスカー積分器により積算処理した。

【結果および考察】図2に酸化チタン粉末 (P25:Degussa)をホルダーに充填し真空排気した 後、355 nm のレーザー光を照射することで生成す



る OH ラジカルのレーザー誘起蛍光スペクトル を示す。図 2 に示すように酸化チタン粉末表面 に 355 nmのレーザー光を照射することでOHラ ジカルの生成が確認できた。次に、OHラジカル 生成における表面水酸基および吸着水の役割を 調べるため、D2Oをセル内に流通させ、282.9nm の OH(A-X,1'-0") の LIF 強度と 287.3nm の OD(A-X,1'-0") の LIF 強度と 287.3nm の OD(A-X,1'-0") のLIF強度の変化を観察した。図3 に示すように、D2Oをセル内に流通させることで、 OHからODの生成、拡散が確認できた。このことは 酸化チタンの紫外光励起でセル内に流通したD2O が酸化チタンの表面水酸基と置換し、さらに光触媒 作用によりODラジカルとして拡散したことを示して いる。

次に、OH-LIFが 355 nm照射直後からどのよう な時間で拡散しているかを調べるため、355nmレ ーザ照射とOH-LIFのプローブ用のレーザ光の遅 延時間を変化させて、そのOH-LIF強度がどのよう に変化するかを調べた。その結果を図4に示す。図 4はセル内に酸素を流通させてOH-LIF強度の拡 散時間がどのように変化したかを示した図である。 酸素分圧が上昇するとともに、OH-LIFの最大強 度を示す時間が遅れ、OHラジカルが酸化チタン表 面から拡散している様子が確認できた。また、酸素 なしの時に比べ、酸素分圧 0.1 Torrの時の方が OH-LIF強度が高い。この結果はOHラジカル生成 経路が酸素分子、過酸化水素(H2O2)を経由して生 成している可能性を示唆している。そのことを確認 するため、酸化チタンにH2O2を含浸させ、OH-LIF 強度の時間変化を調べた。その結果が図5である。 図5に示すように、H2O2に含浸することでOH-LIF 強度が増大した。これは酸化チタンの励起電子が 光触媒作用で生成したH2O2を還元し、OHラジカル を生成する機構(図6参照)

H₂O₂ + e- OH + OH- と対応する。 【参考文献】Y.Murakami, et al., *J.Phys.Chem.B*, 110, 16808(2006), *J.Phys.Chem.C*.111,11339 (2007)

